汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H558

对应国外型号
BC558

■ 主要用途

开关、视频放大。

■ 外形图及引脚排列

TO-92



1—集电极，C
2—基　极，B
3—发射极，E

■ 极限值（T_a=25℃）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃

T_j——结温……150℃

P_C——集电极耗散功率……500mW

V_{CBO}——集电极—基极电压……-30V

V_{CEO}——集电极—发射极电压……-30V

V_{EBO}——发射极—基极电压……-5V

I_C——集电极电流……-100mA

■ 电参数（T_a=25℃）

参数符号	符　号　说　明	最小值	典型值	最大值	单 位	测　试　条　件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	I_C=-100μA，I_E=0
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	I_C=-10mA，I_B=0
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I_E=-100μA，I_C=0
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-15	nA	V_{CB}=-30V,I_E=0
H_{FE}	直流电流增益	110		800		V_{CE}=-5V,I_C=-2mA
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压		-90	-300	mV	I_C=-10mA,I_B=-0.5mA
$V_{CE(sat2)}$			-250	-650	mV	I_C=-100mA,I_B=-5mA
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压		-700		mV	I_C=-10mA,I_B=-0.5mA
$V_{BE(sat2)}$			-900		mV	I_C=-100mA,I_B=-5mA
$V_{BE(on1)}$	基极—发射极导通电压		-660	-750	mV	V_{CE}=-5V,I_C=-2mA
$V_{BE(on2)}$				-800	mV	V_{CE}=-5V,I_C=-10mA
f_T	特征频率		150		MHz	V_{CE}=-5V,I_C=-10mA，f=1MHz
Cob	输出电容			6	pF	V_{CE}=-10V,I_C=0,f=1MHz

■ 分档及其标志

A	B	C
110—220	200—450	420—800